第2章 半导体二极管以及等效模型



模拟电路基础(下)

半导体二极管以及等效模型

2.2 PN结



> 二极管的主要类型

发光二极管

将电能转换成光能的特殊半导体器件, 当管子加正向电压时, 在正向电流激发下, 管子发光, 属电致发光。

使用方法:

- > 发光二极管只有在加正向电压时才发光;
- > 可以通过直流或者交流信号驱动使其发光;
- > 驱动电路需要增加保护电阻。



2.2 PN结

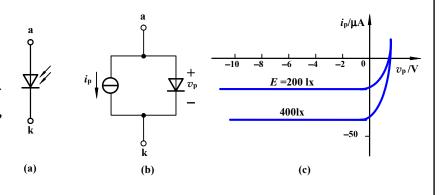




▶ 二极管的主要类型

光电二极管

工作原理:利用光电导效应 工作,PN结工作在<u>反偏态</u>, 当光照射在PN结上时,束缚 电子获得光能变成自由电子, 形成光生电子—空穴对,在 外电场的作用下形成光生电 流。

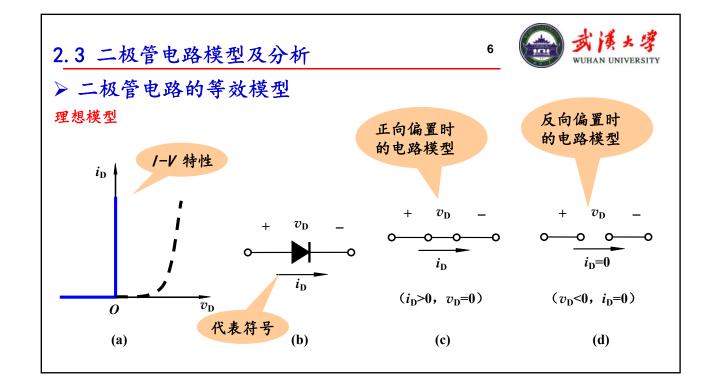


- (a) 符号
- (b) 电路模型
- (c) 特性曲线

2.2 PN结 > 二极管的主要类型 $\circ^{V_{\mathrm{CC}}}$ 5V 光缆 $R_s=500\Omega$ \boldsymbol{R} 43kΩ LED \$\sqrt{\pi} \sqrt{\pi} 0~5V 脉冲串 v_0 发光二极管 光电二极管 发射电路 接收电路 光电传输系统

武漢大學 WUHAN UNIVERSITY

- > 二极管电路的等效模型
 - ▶ 指数模型 精确定量分析
 - ▶ 理想二极管开关模型 — 工程近似定性分析
 - > 二极管恒压降模型
 - ▶ 折线模型基于静态工作点的定量分析(小信号时准确, 大信号容易造成误差)



或漢大學 WUHAN UNIVERSITY

> 二极管电路的等效模型

理想模型

已知 $R_A=R_B=1k\Omega$, $R_C=10k\Omega$ $V_A=5V$ $V_B=3V$

1、假设两个二极管都为正向偏置

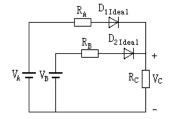
$$\frac{V_{A} - V_{C}}{R_{A}} + \frac{V_{B} - V_{C}}{R_{B}} = \frac{V_{C}}{R_{C}} \quad V_{C} \left(\frac{1}{R_{A}} + \frac{1}{R_{B}} + \frac{1}{R_{C}}\right) = \frac{V_{A}}{R_{A}} + \frac{V_{B}}{R_{B}}$$

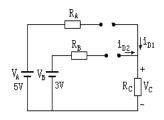
 $V_C = 3.81V$ 二极管都正偏是错误的

2、假设两个二极管都为反向偏置

$$V_c = 0V$$
 二极管都反偏是错误的

3、假定D1导通、D2反偏截止, $i_{D2}=0$ $i_{D1}=\frac{V_A}{(R_A+R_C)}$ $V_C=4.55V$ 结果是正确的

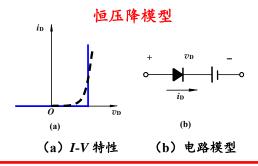




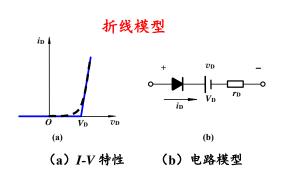
2.3 二极管电路模型及分析

武漢大學 WUHAN UNIVERSITY

> 二极管电路的等效模型



二极管导通后管压降是恒定的,典型值为0.7V(硅二极管)、0.2V(锗二极管)。二极管电流大于1mA时比较准确。

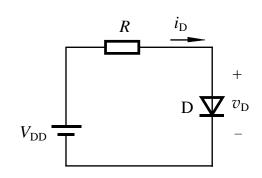


折线模型认为二极管的管压降不是 恒定的,而是随着通过二极管电流的增 加而增加。



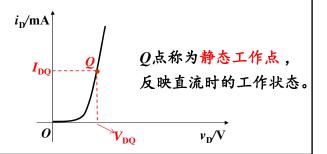
> 二极管电路的等效模型

小信号模型



$oldsymbol{V_{DD}} = oldsymbol{Ri_{D}} + oldsymbol{v_{D}}$

$$\begin{cases} V_{DD} = Ri_{D} + v_{D} \\ f(v_{D}) = i_{D} = I_{S}(e^{v_{D}/V_{T}} - 1) \end{cases}$$



2.3 二极管电路模型及分析



> 二极管电路的等效模型

小信号模型

$$\begin{cases} V_{DD} = Ri_{D} + v_{D} \\ f(v_{D}) = i_{D} = I_{S}(e^{v_{D}/V_{T}} - 1) \end{cases}$$



$$\begin{cases} V_{DD} + v_{s} = Ri_{D} + v_{D} \\ f(v_{D}) = i_{D} = I_{S}(e^{v_{D}/V_{T}} - 1) \end{cases}$$



$$v_{s}$$
 v_{DD}
 v_{DD}

$$\begin{cases} V_{DD} + v_{s} = R (I_{DQ} + \Delta i_{D}) + (V_{DQ} + \Delta v_{D}) \\ = (RI_{DQ} + V_{DQ}) + (R\Delta i_{D} + \Delta v_{D}) \\ f(v_{D}) = I_{DQ} + \Delta i_{D} = I_{DQ} + f'(V_{DQ}) \times \Delta v_{D} \end{cases}$$

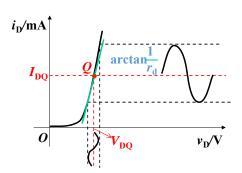
$$f(v_{\rm D}) = f(V_{\rm DQ}) + f'(V_{\rm DQ}) \times (v_{\rm D} - V_{\rm DQ}) + \cdots \approx I_{DQ} + f'(V_{\rm DQ}) \times \Delta v_{\rm D}$$



> 二极管电路的等效模型

小信号模型

$$\begin{cases} V_{DD} + v_{s} = R(I_{DQ} + \Delta i_{D}) + (V_{DQ} + \Delta v_{D}) \\ = (RI_{DQ} + V_{DQ}) + (R\Delta i_{D} + \Delta v_{D}) \\ f(v_{D}) = I_{DQ} + \Delta i_{D} = I_{DQ} + f'(V_{DQ}) \times \Delta v_{D} \end{cases}$$



2.3 二极管电路模型及分析

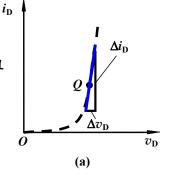
> 二极管电路的等效模型

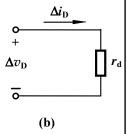
小信号模型

过Q点的切线可以等效成一个微变电阻

$$\mathbb{E} r_{\rm d} = \frac{\Delta v_{\rm D}}{\Delta i_{\rm D}}$$

根据 $i_D = I_S(e^{v_D/V_T} - 1) \approx I_S e^{v_D/V_T}$





得Q点处的微变电导

$$\boldsymbol{g}_{\mathrm{d}} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{i}_{\mathrm{D}}}{\mathrm{d}\boldsymbol{v}_{\mathrm{D}}}\big|_{Q} = \frac{\boldsymbol{I}_{\mathrm{S}}}{\boldsymbol{V}_{T}} \mathrm{e}^{\boldsymbol{v}_{\mathrm{D}}/\boldsymbol{V}_{T}}\big|_{Q} \approx \frac{\boldsymbol{i}_{\mathrm{D}}}{\boldsymbol{V}_{T}}\big|_{Q} = \frac{\boldsymbol{I}_{\mathrm{D}}}{\boldsymbol{V}_{T}} \qquad \text{ If } \boldsymbol{r}_{\mathrm{d}} = \frac{1}{\boldsymbol{g}_{\mathrm{d}}} = \frac{\boldsymbol{V}_{T}}{\boldsymbol{I}_{\mathrm{D}}}$$

常温下(T=300K) $r_{\rm d} = \frac{V_T}{I_{\rm D}} = \frac{26 ({\rm mV})}{I_{\rm D} ({\rm mA})}$

$$N \quad r_{\rm d} = \frac{1}{g_{\rm d}} = \frac{V_T}{I_{\rm D}}$$

或漢大學 WUHAN UNIVERSITY

> 二极管电路的等效模型

小信号模型

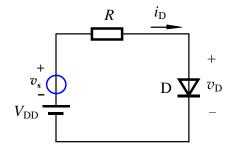
符号中大小写的含义:

大写字母大写下标:静态值(直流),如, I_{R}

小写字母大写下标:总量(直流+交流),如,iB

小写字母小写下标:瞬时值(交流),如,i,

需要熟练掌握,考试扣分项



$$i_{\mathrm{D}} = \frac{1}{R} (V_{\mathrm{DD}} + v_{\mathrm{s}} - v_{\mathrm{D}})$$

$$r_{\rm d} = \frac{V_T}{I_{\rm D}} = \frac{26(\rm mV)}{I_{\rm D}(\rm mA)}$$

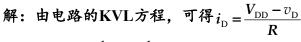
2.3 二极管电路模型及分析

武漢大學 WUHAN UNIVERSITY

> 二极管电路的分析方法

图解分析法

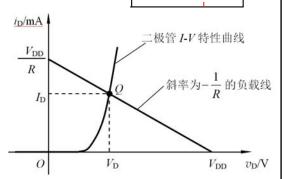
二极管是一种非线性器件,因而其电路一般要采用非线性电路的分析方法,比较复杂,而图解分析法则较简单,前提条件是已知二极管的V-I 曲线。 V_{DD} 例 电路如图所示,已知二极管的V-I特性曲线、电源 V_{DD} 和电阻R,求二极管两端电压 v_{D} 和流过二极管的电流 i_{D} 。



$$\mathcal{P} \quad i_{\mathrm{D}} = -\frac{1}{R}v_{\mathrm{D}} + \frac{1}{R}V_{\mathrm{DD}}$$

Q的坐标值 $(V_{\rm D}, I_{\rm D})$ 即为所求。

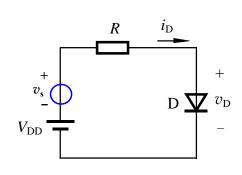
Q点称为电路的工作点。

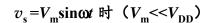


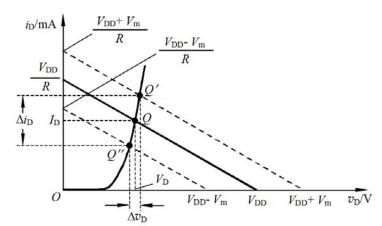
或漢大學 WUHAN UNIVERSITY

> 二极管电路的分析方法

图解分析法







2.3 二极管电路模型及分析

武漢大學 WUHAN UNIVERSITY

> 二极管电路的分析方法

工程近似分析法

当 $V_{\rm DD}$ =10V 时,(R=10k Ω),求电流 $I_{\rm D}$

理想模型 $V_{\rm D}=0\,\mathrm{V}$ $I_{\rm D}=V_{\rm DD}/R=1\,\mathrm{mA}$

恒压模型

 $V_{\rm D}=0.7\,{
m V}$ (硅二极管典型值)

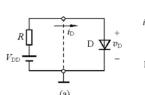
 $I_{\rm D} = (V_{\rm DD} - V_{\rm D}) / R = 0.93 \,\mathrm{mA}$

折线模型

 $V_{\rm th} = 0.5 \, \mathrm{V}$ (硅二极管典型值)

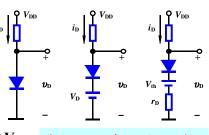
设 $r_{\rm D}=0.2\,{\rm k}\Omega$

 $I_{\rm D} = \frac{V_{\rm DD} - V_{\rm th}}{R + r_{\rm D}} = 0.931 \,\text{mA}$ $V_{\rm D} = V_{\rm th} + I_{\rm D} r_{\rm D} = 0.69 \,\text{V}$





(a) 简单二极管电路 (b) 习惯画法



当V_{DD}=1V 时, 结果如何?

当漢大學 WUHAN UNIVERSITY

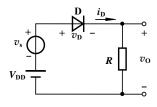
→ 二极管电路的分析方法 工程近似分析法-小信号模型

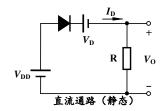
图示电路中, $V_{\rm DD}$ =5V,R=5k Ω ,恒压降模型的 $V_{\rm D}$ =0.7V, $v_{\rm s}$ =0.1sin α t V。(1)求輸出电压 $v_{\rm O}$ 的交流量和总量;(2)绘出 $v_{\rm O}$ 的波形。

解:
$$I_{\rm D} = \frac{V_{\rm DD} - V_{\rm D}}{R}$$
 $r_{\rm d} = \frac{V_T}{I_{\rm D}}$
$$v_{\rm o} = \frac{R}{R + r_{\rm d}} \cdot v_{\rm s}$$

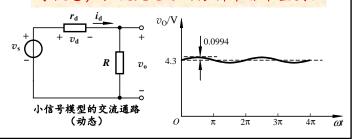
解得:

$$v_0 = V_0 + v_0 = 4.3 + 0.0994 \sin \omega t$$
 (V)





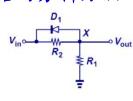
直流通路、交流通路、静态、动态 等概念,在放大电路的分析中非常重要。



2.3 二极管电路模型及分析

武漢大學 WUHAN UNIVERSITY

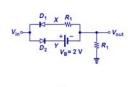
> 二极管电路的分析方法



(a)



> 二极管电路的分析方法

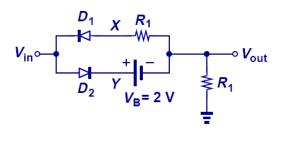


(a)

2.3 二极管电路模型及分析

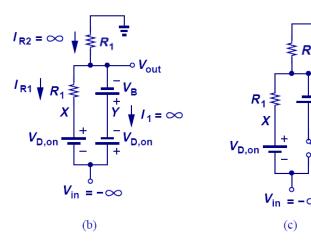


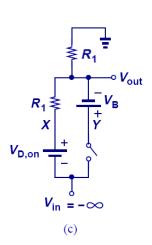
▶ 二极管电路的分析方法





> 二极管电路的分析方法

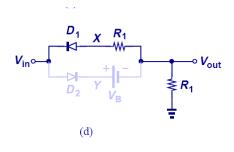


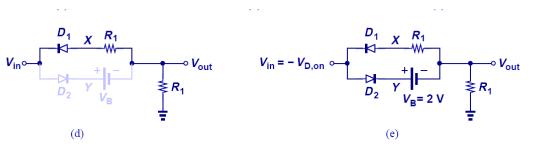


2.3 二极管电路模型及分析



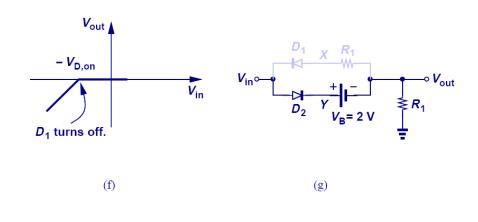
> 二极管电路的分析方法







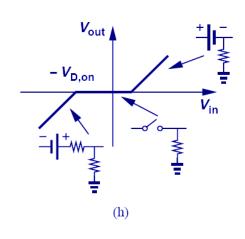
▶ 二极管电路的分析方法



2.3 二极管电路模型及分析



> 二极管电路的分析方法



第2章 半导体二极管以及等效模型



知识点掌握要求

- ●了解本征/P型N型/半导体、多子、少子、扩散、漂移等基本概念
- ●理解PN结的形成以及单向导电性的工作原理
- ●掌握二极管的伏安特性以及主要性能指标
- ●熟练掌握二极管电路的分析方法, 尤其是小信号等效模型及其分析法

课后作业





- 2.4
- 2.10
- 2.12
- 2.13
- 2.15
- 2.18